Docket No.: 4006-271



In re Application of

Alex LONG

U.S. Patent Application No. 10/691,520

Group Art Unit: 1755

Filed: October 24, 2003

Examiner: Michael A. Marcheschi

For: ABRASIVE ARTICLE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

At the time the above application was filed, priority was claimed based on the following applications:

Taiwanese Patent Application No. 91124928 filed October 25, 2002
Taiwanese Patent Application No. 91138091 filed December 31, 2002

Copies of the priority applications are enclosed.

Respectfully submitted,

LOWE HAWPPMAN & BERNER, LLP

Benjamin J. Hauptman Registration No. 29,310

1700 Diagonal Road, Suite 300 Alexandria, Virginia 22314 (703) 684-1111 - BJH:jk (703) 518-5499 Facsimile Date: **June 2, 2005** एए एए एए एए



리 리 리 리 리 ...(6)

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛, 其申請資料如下 :

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunde

: 西元 2002 年 10 Application Date

申·請 號 091124928 Application No.

龍治國 Applicant(s)

Director General

PRIORITY DOCUMENT







發文日期: 西元 2003 年 11 月 24

Issue/ Date

發文字號: 09221190500

Serial No.

BEST AVAILABLE COPY



申請日期:	案號:	
類別:		,

(以上各欄由本局填註)

發明專利說明書			
_	中文	切割研磨片之製造方法及結構	
發明名稱	英文		
	姓 名 (中文)	1. 龍治國	
'二 發明人	姓 名 (英文)	1. Alex C. LONG	
		1. 中華民國 1. 台北縣永和市中和路375號9樓(9F, No. 375, Junghe Rd., Yunghe City, Taipei Hsien, Taiwan 234, R.O.C.)	
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 龍治國	
二、請人	姓 名 (名稱) (英文)	1. Alex C. LONG	
	國籍住、居所(事務所)	1. 中華民國 1. 台北縣永和市中和路375號9樓(9F, No. 375, Junghe Rd., Yunghe City, Taipei Hsien, Taiwan 234, R.O.C.)	
	代表人 姓 名 (中文)	1.	
	代表人姓 名(英文)	1.	



四、中文發明摘要 (發明之名稱:切割研磨片之製造方法及結構)

The same of the sa

英文發明摘要 (發明之名稱:)



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

無

五、發明說明(1)

【發明領域】

本發明係有關於一種切割研磨片之製造方法及結構, 尤指一種運用於各種切割研磨工具上容易更換之切割研磨 片,而切割研磨片上之研磨面具等高性者。

【發明背景】

隨著現今工業發展朝向精密度高之趨勢下,研磨設備及技術應用在超精密模具或元件加工上,其切割研磨工具要求之研磨精度也日益增高,因此該切割研磨技術可應用於半導體、航太、精密陶瓷等高精度要求之工業中。





五、發明說明(2)

落,進而使該金屬基底 10受到破壞使該研磨粒 14脫落,尤其當保護層 16已脫落之情況下而進行切割研磨接觸到酸鹼液時,更容易破壞金屬基底 10使研磨粒 14脫落降低研磨工具之使用壽命。

因此,本發明即在如何針對上述問題而提出一種切割研磨片之製造方法及結構,不僅可改善研磨粒之分佈不均、研磨面不等高、固結能力不佳及固結高度過高之缺點外,又可增加研磨粒之研磨壽命及更換容易之功能,使可解決上述之問題。

【發明目的及概要】

本發明之主要目的在於,提供一種切割研磨片之製造方法及結構,其係提高研磨粒之固結能力,降低研磨粒之固結高度使達不易脫落及增加研磨之壽命之目的。

本發明之次要目的,在於提供一種切割研磨片之製造方法及結構,其係使研磨粒分佈均匀,且研磨粒之研磨面等高,以增加切割研磨之精度及效率。

本發明之又一目的,在於提供一種切割研磨片之製造方法及結構,其係使切割研磨片可容易運用於各種不同造型之研磨工具上,且達容易更換之目的。

為達以上之目的,本發明係將複數研磨粒置於一基準板上,並使研磨粒底端抵住基準板表面;再於基準板上形成一基礎鍍層,將研磨粒固結於該基準板上;再放置複數抗酸鹼顆粒於研磨粒與研磨粒之縫隙中將縫隙填滿,可利用與基礎鍍層相同之材料形成一固定鍍層,將抗酸鹼顆粒





五、發明說明 (3)

固結於縫隙中;接著利用與基礎鍍層不同之材料,於固定鍍層上形成一適當高度之最終反應式鍍層並移除基準板;最後將該基礎鍍層及固定鍍層去除。

本發明另外提供一種切割研磨片之製造方法,其係將複數研磨粒置於一基準板上,並使研磨粒底端抵住基準板表面;再於基準板上形成一基礎鍍層,將研磨粒固結於該基準板上;接著利用與基礎鍍層不同之材料,於基礎鍍層上形成一適當高度之最終反應式鍍層並移除基準板;移去後再將該基礎鍍層去除;最後於研磨粒與研磨粒之縫隙中固結複數抗酸鹼顆粒將縫隙填滿。

為達以上之目的,本發明係提供一種切割研磨片之結構,其係在一基底面上固結有複數顆研磨粒,且該研磨粒之研磨面係為同一水平高度,而研磨粒周圍與基準面固結之形狀其係為朝向研磨面突起,並於研磨粒與研磨粒之縫隙中固結有複數抗酸鹼顆粒,且於在研磨面上、抗酸鹼顆粒及基底表面上批覆有一層保護層,以防止酸鹹物質侵蝕基底面。

茲為使 貴審查委員對本發明之結構特徵及所達成之功效更有進一步之瞭解與認識,謹佐以較佳之實施例圖及配合詳細之說明,說明如後:

【圖號對照說明】

- 10 金屬基底
- 12 鍍層
- 14 研磨粒





五、發明說明 (4)

- 16 保護層
- 20 基準板
- 22 研磨粒
- 24 基礎鍍層
- 26 抗酸鹼顆粒
- 28 固定鍍層
- 30 最終反應式鍍層
- 32 保護層
- 34 網層體
- 36 網孔
- 38 基底
- 40 基準板

【具體實施例詳細說明】

第二圖至第六圖分別為本發明之較佳實施例在製作切割研磨片之各製程構造剖視示意圖,如圖所示,本發明之製作方法其係包括有下列製程:

請參閱第二圖,如圖所示;本發明係於一基準板 20上放置有複數研磨粒 22,且研磨粒 22底端抵住基準板 20之表面,該研磨粒 22係為具有切割研磨能力之材料如鑽石、氮化硼及氧化鋁等材料,並以無機鍍覆表面處理技術方式,在基準板 20上形成一適當高度之基礎鍍層 24,將研磨粒 22固結於基準板 20上,該無機鍍覆表面處理技術其可為電鍍、化學鍍、鍍鉻及轉化膜等。

請參閱第三圖,當研磨粒22固結於基準板20上後,並

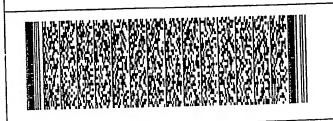


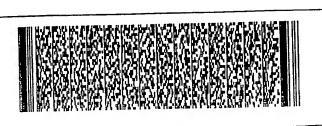


五、發明說明 (5)

於研磨粒 22與研磨粒 22之縫隙中放置複數顆抗酸鹼顆粒 26 將縫隙填滿,接著可利用與基礎鍍層 24相同材料,使用無機鍍覆表面處理技術方式形成一適當高度之固定鍍層 28,依加工製程需要亦可選擇適當不同之材料,將抗酸鹼顆粒 26固結於縫隙中,抗酸鹼顆粒 26不僅能抗酸鹼亦能耐研磨如鑽石、陶瓷、高分子材、碳化鎢、氮化硼等。

請參閱第四圖及第五圖,在固定鍍層 28及抗酸鹼顆粒 26表面上,使用無機鍍覆表面處理技術方式形成一適當高 度之最終反應式鍍層 30,並移除基準板 20,接著利用可去 除基礎鍍層 24及固定鍍層 28之溶劑、使用加熱及研磨等方式去除基礎鍍層 24及固定鍍層 28。





五、發明說明 (6)

請參閱第六圖,當去除基礎鍍層 24及固定鍍層 28之後,在最終反應式鍍層 30、研磨粒 22及抗酸鹼顆粒 26表面上,以蒸鍍、濺鍍、噴塗及各種相關之方式形成一保護層 32,該保護層 32可為鉻化物、鈦化物、高分子膜及頻鑽石膜等。

請參閱第七圖及第八圖,如圖所示;其中在上述第二圖之製程前,尚可於基準板 20上設置一網層體 34,而將研磨粒 22個別設置於網層體 34之每一網孔 36內,而研磨粒 22底端需抵住基準板 20;而使製作出之切割研磨片之研磨粒 22可均匀分佈。

此外,在上述之製程中可省略第三圖之製程,即首先將研磨粒 22置於基準板 20上,而研磨粒 22底端抵住該基準板 20之表面上;在於基準板 20上形成基礎鍍層 24,將研磨粒 22固結於該基準板 20上;接著於基礎鍍層 24上,形成最終反應式鍍層 30並移除基準板 20;而於此製程之後進行加熱處理,增加研磨粒 22之固結能力,然後去除基礎鍍層 24;再將複數抗酸鹼顆粒 26固結於研磨粒 22與研磨粒 22之縫隙中,而將縫隙填滿,最後即在最終反應式鍍層 30、研磨粒 22及抗酸鹼顆粒 26表面上形成保護層 32。

請參閱第九圖,係本發明切割研磨片結構剖面示意圖,如圖所示切割研磨片之結構,其係以最終反應式鍍層為基底 38, 基底 38上所固結之研磨粒 22因使用上述之製程方法,而使研磨粒 22之研磨面係為同一水平面之高度而增加切割研磨之精度及效果,且研磨粒 22周圍之固結形狀係呈





五、發明說明 (7)

向研磨面突起之形狀,而增加研磨粒 22之支撑力使固著能力增強,而且固結研磨粒 22之鍍層較一般習用之固結鍍層低,也就是說可切割研磨之高度較高,然而於基底 38上之研磨粒 22與研磨粒 22的縫隙中係固結有抗酸鹼顆粒 26可防止切割研磨片於使用時遇到酸鹼物時破壞基底 38使研磨粒 22脱落減少使用壽命,並於基底 38、研磨粒 22及抗酸鹼顆粒 26表面上批覆有保護層 32以多一層保護。

請參閱第十圖,如圖所示;當於上述之製作切割研磨片之製作切割研磨片,條可使用不同形狀之基準板40作為基準面,可作成不同形狀之切割研磨片,即本發明切割研磨片。如將配之切割研磨片,如於手術配之切割研磨片,甚至切割研磨器具。

綜上所述,本發明實為一具有新穎性、進步性即可供 產業上利用者,應符合我國專利法專利申請要件無疑,爰 依法提出發明專利申請,祈 鈞局早日賜至准專利,至感 為禱 。

惟以上所述者,僅為本發明一較佳實施例而已,並非用來限定本發明實施之範圍,故舉凡依本發明申請專利範圍所述之形狀、構造、特徵及精神所為之均等變化與修飾,均應包括於本發明之申請專利範圍內。





圖式簡單說明

第一圖係習知研磨工具之剖視示意圖;

第二圖係本發明初步電鍍製程之構造剖視示意圖;

第三圖係本發明固結抗酸鹼顆粒製程之構造剖視示意圖;

第四圖係本發明最終電鍍製程之構造剖視示意圖;

第五圖係本發明去除初步鍍層製程之構造剖視示意圖;

第六圖係本發明形成保護層製程之構造剖視示意圖;

第七圖係本發明使用網層體排列研磨粒製程之剖視示意圖

;

第八圖係本發明使用網層體排列研磨粒製程之上視示意圖

,

第九圖係本發明切割研磨片結構剖面示意圖;

第十圖係本發明於製程中使用不同形狀為基準板之剖視示意圖。



1 · 一種切割研磨片之製造方法,其係包括有下列步驟: 將複數研磨粒置於一基準板上,並使該研磨粒底端抵 住該基準板;

於該基準板上形成一基礎鍍層,將該研磨粒固結於該基準板上;

於該研磨粒與研磨粒之縫隙中放置複數抗酸鹼顆粒將縫隙填滿;

形成一適當高度之固定鍍層將該抗酸鹼顆粒固結於縫隙中;

於該固定鍍層上,形成一適當高度之最終反應式鍍層,該最終反應式鍍層之材料係不同於該基礎鍍層及固定鍍層之材料;

移去該基準板;及

去除該基礎鍍層及該固定鍍層。

- 2 ·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中在將複數研磨粒置於一基準板上之步驟前,尚 可在該基準板上設置一網層體其係具有複數網孔,而 將該研磨粒個別設置於該網層體之每一網孔中。
- 3 · 如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該固定鍍層使用之材料可相同於該基礎鍍層。
- 4 · 如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎鍍層及該固定鍍層之步驟前,尚 可進行加熱處理,使該最終反應式鍍層與該研磨粒產 生化學鍵結反應,而形成穩固結合。



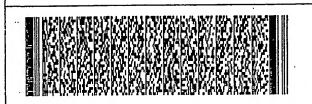
- 5 ·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎反應鍍層步驟後,尚可在最終反 應式鍍層、該研磨粒及該抗酸鹼顆粒表面上形成一保 護層,該保護層可為金屬化合物、高分子膜及類鑽石 膜之其中之一者。
- 6 · 如申請專利範圍第 5 項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該金屬化合物可為鈦化物、鉻化物其中之一者 。
- 7·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於該研磨粒上形成一基礎鍍層、一固定鍍層及 一最終反應式鍍層之步驟中,其係利用無機鍍覆表面 處理技術方式形成。
- 8 ·如申請專利範圍第了項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該無機鍍覆表面處理技術方式,其可為電鍍、 化學鍍、鍍鉻、高分子膜及轉化膜之其中之一者。
- 9 ·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該研磨粒其係為鑽石時,該基礎鍍層可為銅, 而該最終反應式鍍層其可為鉻、銛、鎢、鈦、鋅、鐵、錳之金屬及合金之其中之一者。
- 10·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該研磨粒其係為氮化硼時,該基礎鍍層可為銅 ,而該最終反應式鍍層其可為鋁、硼、碳及矽之其中 之一者。
- 11.如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法

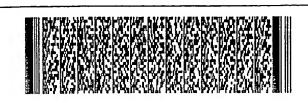


- ,其中該研磨粒其係為氧化鋁時,該基礎鍍層可為銅,而該最終反應式鍍層其可為鋁、硼、碳及矽之其中 之一者。
- 12·如申請專利範圍第1項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎鍍層及該固定鍍層之步驟中,其 係採用可去除基礎鍍層及固定鍍層之溶劑、加熱及研 磨去除方式之其中之一者。
- 13·一種切割研磨片之製造方法,其係包括有下列步驟: 將複數研磨粒置於一基準板上,並使該研磨粒底端抵 住該基準板;
 - 於該基準板上形成一基礎鍍層,將該研磨粒固結於該基準板上;
 - 於該基礎鍍層上,形成一適當高度之最終反應式鍍層,該最終反應式鍍層之材料係不同於該基礎鍍層之材料;

移去該基準板;及去除該基礎鍍層。

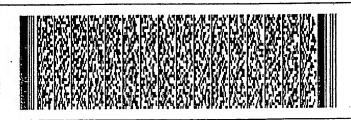
- 14·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中在將複數研磨粒置於一基準板上之步驟前,尚 可在該基準板上設置一網層體其係具有複數網孔,而 將該研磨粒個別設置於該網層體之每一網孔中。
- 15·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎鍍層之步驟前,尚可進行加熱處 理,使該最終反應式鍍層與該研磨粒產生化學鍵結反





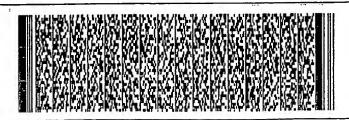
應,而形成穩固結合。

- 16·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法,其中於去除該基礎反應鍍層步驟後,尚可在該研磨 粒與研磨粒之縫隙中固結複數抗酸鹼顆粒將縫隙填滿
- 17·如申請專利範圍第16項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於固結該抗酸鹼顆粒將縫隙填滿之步驟後,尚 可在該最終反應式鍍層、該研磨粒表面上及該抗酸鹼 顆粒表面上形成一保護層,該保護層可為金屬化合物 、高分子膜及類鑽石膜之其中之一者。
- 18·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎反應鍍層步驟後,尚可在最終反 應式鍍層及該研磨粒表面上形成一保護層,該保護層 可為金屬化合物、高分子膜及類鑽石膜之其中之一者
- 19·如申請專利範圍第 17項或第 18項所述之切割研磨片之 製造方法,其中該金屬化合物可為鈦化物、鉻化物其 中之一者。
- 20·如申請專利範圍第13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於該研磨粒上形成一基礎鍍層及一最終反應式 鍍層之步驟中,其係利用無機鍍覆表面處理技術方式 形成。
- 21. 如申請專利範圍第 20項所述之切割研磨片之製造方法,其中該無機鍍覆表面處理技術方式,其可為電鍍、



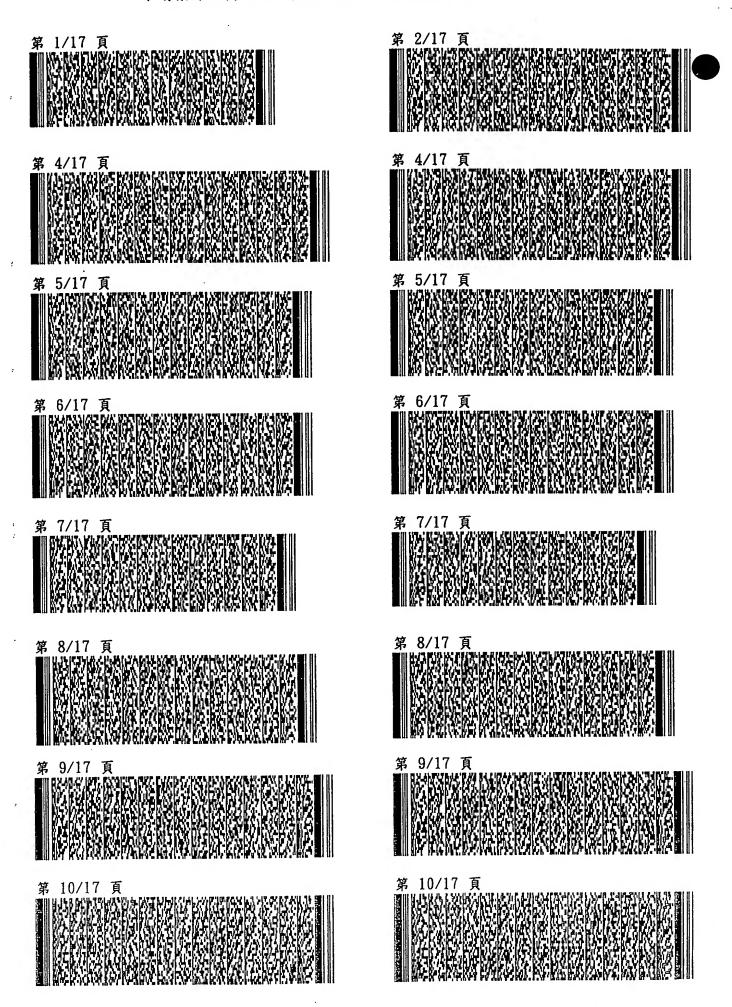
化學鍍、鍍鉻及轉化膜之其中之一者。

- 22·如申請專利範圍第13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該研磨粒其係為鑽石時,該基礎鍍層可為銅, 而該最終反應式鍍層其可為鉻、銛、鎢、鈦、鋅、鐵、錳之金屬及合金之其中之一者。
- 23·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該研磨粒其為氮化硼時,該基礎鍍層可為銅, 而該最終反應式鍍層其可為鋁、硼、碳及矽之其中之 一者。
- 24·如申請專利範圍第13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中該研磨粒其係為氧化鋁時,該基礎鍍層可為銅 ,而該最終反應式鍍層其可為鋁、硼、碳及矽之其中 之一者。
- 25·如申請專利範圍第 13項所述之切割研磨片之製造方法 ,其中於去除該基礎鍍層之步驟中,其係採用可去除 基礎鍍層之溶劑、加熱及研磨去除方式之其中之一者
- 26·一種切割研磨片之結構,其係於一基底面上固結有複數研磨粒,而該研磨粒之研磨面係為同一水平面之高度,該研磨粒周圍之固結形狀係呈向研磨面突起之形狀。
- 27·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其中該切割研磨片係可為任何形狀。
- 28. 如申請專利範圍第26項所述之切割研磨片之結構,其

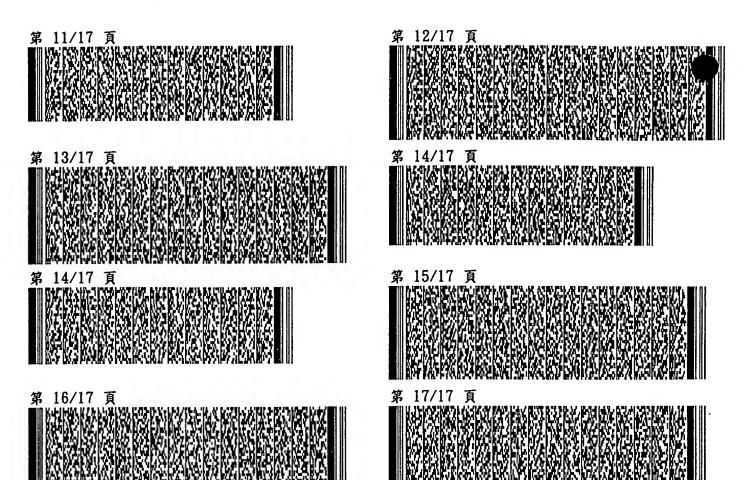


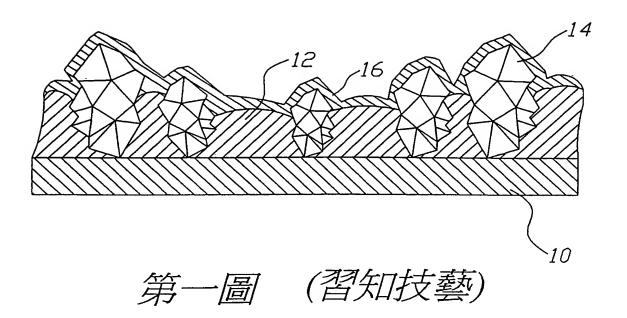
- 中該切割研磨片係可裝設於各種切割研磨之工具上。 29·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其 中該研磨粒為鑽石時,該基底材質其可為鉻、鈷、鷂
 - 、鈦、鋅、鐵、錳之金屬及合金之其中之一者。
- 30·如申請專利範圍第26項所述之切割研磨片之結構,其中該研磨粒為氮化硼時,該基底材質其可為鋁、硼、碳及矽之其中之一者。
- 31·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其中該研磨粒氧化鋁時,該基底材質其可為鋁、硼、碳及矽之其中之一者。
- 32·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其中該研磨粒及該基底表面上設有一保護層。
- 33·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其中該研磨粒與研磨粒之縫隙中係固結有複數抗酸鹼顆粒。
- 34·如申請專利範圍第 26項所述之切割研磨片之結構,其中該研磨粒、該基底及該抗酸鹼顆粒表面上設有一保護層。
- 35·如申請專利範圍第 32項或第 34項所述之切割研磨片之 結構,其中該保護層其可為金屬化合物、高分子膜及 類鑽石膜之其中之一者。
- 36·如申請專利範圍第 35項所述之切割研磨片之結構,其中該金屬化合物可為鈦化物、鉻化物其中之一者。

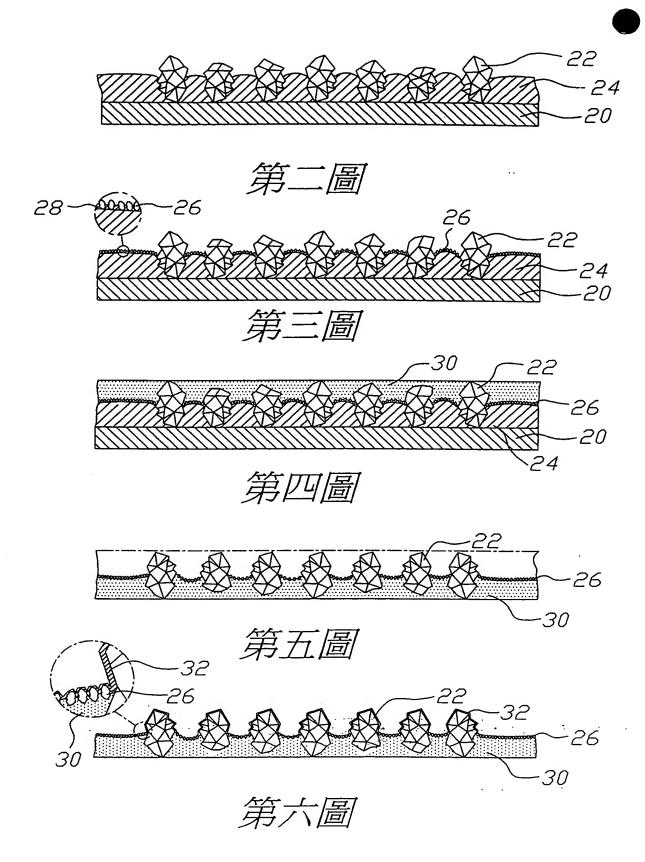


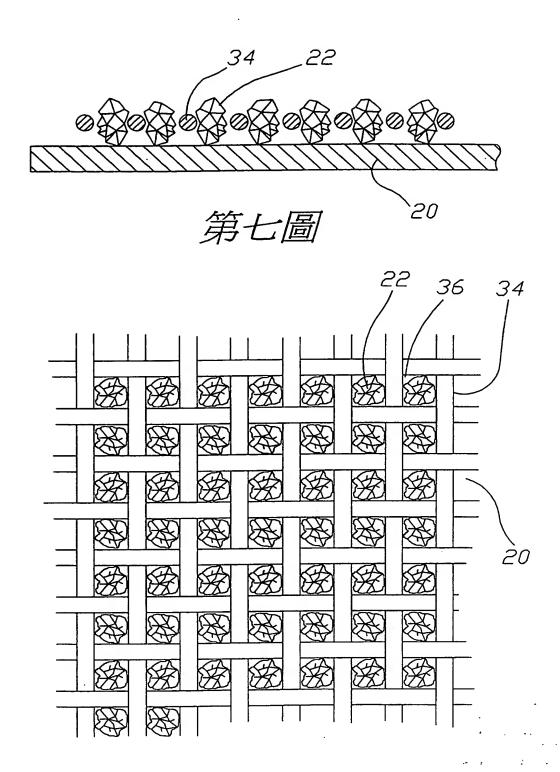


申請案件名稱:切割研磨片之製造方法及結構

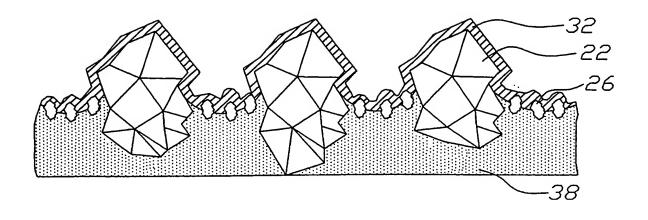








第八圖



第九圖

